KEK-ATF における CSR によるエミッタンス増大実験の検討

奥木敏行*、浦川順治、久保浄、黒田茂、田内利明、早野仁司 高エネルギー加速器研究機構 〒305-0801 つくば市大穂 1-1

概要

低エミッタンスビームを低中エネルギー領域において 偏向させると、ビーム自らが放射増幅するコヒーレント 放射光(CSR)の影響で、ビームのエミッタンスが増大 する現象が提唱されている。この CSR によるエミッタ ンス増大はリニアコライダーや SASE-FEL におけるバ ンチ長圧縮部において影響を与えると懸念されている。 現在おこなわれている CSR に対する研究は、自由空間 での CSR によるエミッタンス増大の定量的な検討や完 全導体の平行平板を運動するビームに対する遮蔽効果 が理論的に検討されているだけである。実際の加速器 での CSR の確証や、実際の加速器で使われている真空 ダクトでの遮蔽効果の検証に関しては計画段階の施設 が数カ所存在するが、実際に検証された例は未だ無い。 KEK-ATF ダンピングリングは水平方向エミッタンス が2 nmrad と世界でも例を見ない低エミッタンスビー ムを安定に作り出せるため CSR の検証には最適な加速 器である。本稿では KEK-ATF における実験に対する 検討結果を報告するものである。

コヒーレント放射光 (CSR) 1

CSR ポテンシャルとエミッタンス増大 11

電子ビームが偏向電磁石を通過するとき、シンクロトロ ン放射光を放出する。このシンクロトロン放射光はビー ムの進行方向に対して $1/\gamma$ 程度の広がりを持ち光速で 伝搬する。一方、電子ビームは偏向電磁石内では円弧を 描くように進むため、放射光に対して長い軌道長を進む ことになる。このため、ビーム内の後方の電子が放出し た放射光はビーム内の前方の粒子へと到達し、放射光の 電磁場と相互作用し、放射光は増幅されることになる。 これが偏向電磁石内での CSR の原理である。

CSR により電子ビームはエネルギーを失うことにな る。この失われるエネルギーは wake field のようにポ



図 1: CSR のポテンシャル。ここでは真空ダクトの遮 蔽効果は入れていない。

* E-mail:toshiyuki.okugi@kek.jp

テンシャルを使って表わすことができる[1]。

$$V_{\rm CSR}(s) = -\frac{2Ne}{\sqrt{2\pi}\sqrt[3]{3\rho^2\sigma_z^4}}F(s/\sigma_z) \tag{1}$$

ここで $F(s/\sigma_z)$ は図 1 で表わされるようになる。 σ_z は バンチ長、ρはビームの曲率半径を表わしている。CSR によるポテンシャルは wake field の場合と違い、その 性質上ビームの前方により大きな影響を与えることがわ かる。またポテンシャルの大きさはビームエネルギーに 依存しないため、ビームエネルギーが高くなると CSR の効果は無視されるので、CSR は低中エネルギー領域 で大きな効果を与えるということがわかる。また、この ようなビーム内のエネルギー変調がシケイン内などの アクロマートな系の中で起こると、系の出口では、ビー ムの一部でアクロマートな条件が破れ、結果として水平 方向のエミッタンス増大を引き起こすことになる。

1.2 真空チャンバーの遮蔽効果

今まで述べてきた話は全てビームの近くに導電体など 電磁場を乱す障害物が存在しない自由空間内での電子 ビームの運動についてだった。しかし、実際の加速器 ではビームは真空チェンバーの中を運動し、真空チェン バーは導電体でできているため遮蔽効果を与える。この 遮蔽効果については高さ h の完全導体からなる平行平 板に対しての計算がなされている [2]。遮蔽効果の起こ る条件は

$$\sigma_z > \frac{h}{\pi} \sqrt{\frac{3h}{2\pi\rho}} \tag{2}$$

であり、この遮蔽効果に対する実効的な遮蔽長は $\sqrt{h\rho}$ 程度とされる。また、この拡張として高さh、幅wの 真空チェンバーを通過する際の遮蔽効果を

$$\sigma_z > \sqrt{\frac{h^2 w}{\pi^2 \rho}} \tag{3}$$

と見積もることもある。しかし、この式には2、3倍程 度の不定性があり、正確に確かめられたものではない。

2 KEK-ATF に設置可能なバンチ長圧縮装置

2.1 KEK-ATF で生成されるビーム

KEK-ATF は文部科学省高エネルギー加速器研究機構 内で運転されている次世代のリニアコライダーのための 試験加速器である。KEK-ATF から取り出されるビー ムの主なパラメーターを表1にまとめる。ビームエミッ タンスは水平方向で 2 nmrad、垂直方向 20 pmrad と 世界でも最小の値を出している。また、一度リングを通

表 1: KEK-ATF ダンピングリングを出たビームのパラ メーター。表の値はビーム内電子散乱の効果も含めた ビーム強度が 1×10^{10} のときの値を示してある。

ビームエネルギー	E	$1.28~{\rm GeV}$
ビーム強度	N_e	1×10^{10}
水平エミッタンス	ε_x	2 nmrad
垂直エミッタンス	ε_y	20 pmrad
バンチ長	σ_z	$7 \mathrm{~mm}$
運動量拡がり	σ_p/p	0.85~%

しているため、RF 電子銃などで生成されるビームに比 べても安定性も良く、ビームテールも少ない。またビー ムエネルギーも 1.28GeV とさほど高くない。これらの ことを考慮に入れると KEK-ATF は CSR の試験を行 なうのに良いビームを供給できる加速器であることが わかる。

2.2 バンチ圧縮装置の設計

装置の単純化を考えるため、ここでは 90°回転型のバ ンチ圧縮装置を考えることにする。ここで言う回転角は 縦方向位相平面 (ビーム進行方向の位置とエネルギーの ずれ)での回転角を意味する。90°回転型のバンチ圧縮 装置はビームの進行方向に依存したエネルギー差を形 成する空胴部とエネルギーが違う粒子の軌道長を変え る偏向部とで構成される。空胴部は現在 KEK-ATF リ ニアックで使用している S-band 加速管を使用すること を仮定する。式 (1)でもわかるように、バンチ長は短け れば短いほど CSR ポテンシャルは大きくなるが、圧縮 できるバンチ長には空胴部や偏向部での非線形特性か らくる制限がある。

90°回転型のバンチ圧縮装置前でのビーム進行方向の 位置 Δz_i と圧縮装置後のビーム進行方向の位置 Δz_f と の関係は

$$\Delta z_f = \left(1 - \frac{kR_{56}VC}{E - VS}\right) \Delta z_i - \frac{k^2 R_{56} \{V(1 + 2C^2) - ES\}}{2(E - VS)^2} \Delta z_i^2 + \frac{k^3 R_{56}VC(E + 8VS)}{6(E - VS)^2} \Delta z_i^3 + o(\Delta z_i^4) \quad (4)$$

のように表わせる。ここで $k = 2\pi f/c$, $S = \sin \delta$, $C = \cos \delta$ である。式 (4) の第 1 項、第 2 項が空胴にかける 高周波の電圧と位相を調整してキャンセルすることは できる。しかし第 3 項は消すことのできない値として 残ってしまう。この第 3 項がバンチ長圧縮の制限値を作 ることになる。この非線形の効果を無視するための条件 として

$$2\sigma_{z,f} = 2R_{56}\frac{\sigma_{p,i}}{p} > \Delta z_f(2\sigma_{z,i}) \tag{5}$$

と置き、表 1 のパラメーターを使うと、S-band 高周波 空胴を使ったときのバンチ長圧縮の限界値として 850µm という値が求められる。また、このときの基本パラメー ターを表 2 にまとめる。

表 2: バンチ長圧縮装置の基本パラメーター。

空胴周波数	f	$2856 \mathrm{~MHz}$
空胴電圧	V	$21.4 { m MeV}$
空胴位相	φ	2.87°
運動量縮約因子	R_{56}	$1.00 \mathrm{~m}$
最終バンチ長	σ_z	$850 \ \mu { m m}$



図 2: KEK-ATF に導入可能なバンチ圧縮装置のビーム ラインと運動量分散関数。

表2のパラメーターを基に設計されたビームライン を図2に示す。このようなバンチ長圧縮装置を実現する ためには空胴部は現在 KEK-ATF で使用している3m の加速管1本で充分である。また偏向部は1.35Tの磁 場をかけた1.5m 長の rectangular 型の偏向電磁石4個 からなるシケインによって構成されている。偏向電磁石 磁場を大きくとったのはCSRの効果を大きくとるため と真空チェンバーの遮蔽長を短くすることにより装置を 簡略化するためである。また、シケイン中央の運動量分 散関数は最大1.25m と大きく、このときの水平方向の ビームサイズは約1cm となるため、シケイン中央部で のチェンバー系は充分大きくとる必要がある。

3 CSR の定量的評価

3.1 トラッキングコード

CSR の影響を調べるために 6 次元のトラッキングコー ドの開発をおこなった。マクロ粒子モデルで粒子トラッ キングをおこなう手法でコードは形成され、CSR の影 響は式 (1) のポテンシャルによるエネルギーの変化とし て織り込んだ。その結果、真空チェンバーによる遮蔽効 果については採り入れられないが、ビームラインを設計 する上では、遮蔽効果の無い状態を最悪の状態として捉 えることができ、エミッタンス増大の上限値を求める上 では、充分であると考えることができよう。また、この コードには CSR のみでなく、シンクロトロン放射光や wake field の影響も織り込んである。

3.2 水平方向エミッタンス増大の評価

水平方向エミッタンスの増大は上記のトラッキングコードを用いておこなわれた。理論的には最終のバンチ長は 850µm であったが、トラッキングの結果最終バンチ長は1088µm という結果となった。これは図3に示すよ



図 3: バンチ圧縮装置で圧縮されたビームの縦方向の位 相空間。(a) 解析的に解かれたパラメーターを使った位 相空間 (バンチ長 1088µm)。(b) バンチ長が最短になる ように調整した後の位相空間 (バンチ長 977µm)。

うに3次の非線形の影響によるものである。また若干 のパラメーターの微調により図3(b)に示すようにバン チ長を若干小さくすることができる。

水平方向エミッタンスの増大はシケイン部のビーム 光学系により変化する。図4にはシミュレーション例 を示す。図 4 (a) には運動量分散関数を、(b) にはべー タ関数を、(c)にはビームラインに沿った規格化水平方 向エミッタンスの変化を示している。なおシケイン中 央部におけるエミッタンスの上昇はクロマティックな収 差からくるもので、CSR の影響が無いときにはシケイ ンの出口部分では完全にゼロになるものである。しか しながら、CSR の影響でシケインを出た後もエミッタ ンスの増大が存在していることがわかる。また図 5は $\alpha_x = 0$ の条件を保ちながら水平方向ベータ関数を変化 させたとき、シケイン出口に於ける規格化エミッタンス をシケイン中央部分でのベータ関数の関数として表わ したものである。水平方向ベータ関数を変化させること によりシケイン出口でのエミッタンスの値を変化させる ことができることがわかる。このように幾つかのビーム 光学系において、水平方向のエミッタンス増大を調べる ことにより CSR におけるエミッタンス増大が正しく理 解されているかを判断することができる。



図 4: トラッキングコードによりシミュレートされたエ ミッタンス増大。(a) 運動量分散関数。(b) ベータ関数。 (c) エミッタンス増大の様子。



図 5: ビーム光学系の違いによるエミッタン増大の変 化。シケインの中央で $\alpha_x = 0$ として、そこでのベータ 関数 β_{*x} を変えながらエミッタンス増大をシミュレー トした。

3.3 遮蔽効果の影響

遮蔽効果の影響は式 (2)、(3)を使って評価することが できる。シケインに使われている偏向電磁石の曲率半径 は ρ = 3.16m、バンチ圧縮装置の最後部でのバンチ長は 約 1mm なので、式 (2)により遮蔽効果を及ぼすため に必要な真空チェンバーの高さはh = 4.0cm 程度であ ることがわかる。また実効的な遮蔽長もh = 4.0cm の とき約 35cm となり、最後の偏向電磁石の出射部におい て、このような縦方向へ変化するコリメーターを設置す ることにより遮蔽効果についても確かめることが可能 である。式 (3)についても同時に調べるためには水平方 向へも変化するコリメーターを作成せねばならず多少 複雑な装置が必要になるが、原理的に不可能なことでは ない。

4 **まとめ**

KEK-ATF のビームに対する CSR の確証、および、真 空ダクトでの遮蔽効果の検証に対する検討をおこなっ た。検討の結果、真空チェンバーによる遮蔽効果を考 慮に入れないとした場合、水平方向のエミッタンスが 15-50% も上昇することがわかった。このエミッタンス 増大はビーム光学系の設計により値が変化し、この変化 を注意深く調べることにより CSR によるエミッタンス 増大を詳しく調べられることもわかった。更に真空チェ ンバーによる遮蔽効果は真空チェンバーの高さが4cm 程度と比較的実現しやすい程度の大きさから起こり、可 変式のコリメーターを作成することにより詳しく調べら れることもわかった。これらの考察から KEK-ATF は CSR の検証には最適な加速器であると結論づけられる。

5 謝辞

本稿を書くにあたり ATF-II ミーティングに参加して、 共に議論して下さった方々には大変有意義なコメントを 多く頂いた。ここに感謝申し上げます。

6 REFERENCES

- [1] Y.S.Derbenev et al., TESLA-FEL 95-05(1995).
- [2] S.A.Kheifets et al., CERN SL-95-92(1995).